



Image may be representation.  
See specs for product details.

## FDP047N08

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FDP047N08
<b>Hersteller / Marke:</b>	FDK America
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 75V 164A TO-220
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FDP047N08.pdf</a> <a href="#">2.FDP047N08.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 36380 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP047N08
Hersteller	FDK America
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 164A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	36380 pcs Stock
Hersteller-Teilenummer	FDP047N08
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 164A TO-220
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Expanded Beschreibung	N-Channel 75V 164A (Tc) 268W (Tc) Through Hole
RoHS Status	Tube
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Polarisation	TO-220-3
Spannung - Durchschlag	TO-220-3
Kapazitätsverhältnis	268W (Tc)
FET-Merkmal	N-Channel
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75V
Rds On (Max) @ Id, Vgs	164A (Tc)
VGS (th) (Max) @ Id	4.7 mOhm @ 80A, 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5V @ 250µA
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	152nC @ 10V
Spannung - Prüfung	9415pF @ 25V
Vgs (Max)	10V
IGBT-Typ	±20V

FDP047N08 ist neu im Original, Suche FDP047N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP047N08 FDK America mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP047N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

**FDP047AN08AO**  
F  
FDP047AN08AO F

**FDP047AN08AO\_F102**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3

**FDP047N08AO**  
FSC  
FDP047N08AO FSC

**FDP047N08-F102**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 75V 164A TO220-3

**FDP047AN08AO**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB

**FDP047AN08AO-F102**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3

**FDP047N08**  
Fairchild/ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 75V 164A TO-220

**FDP047N10**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
MOSFET N-CH 100V 120A TO-220

### heiße Teile

Mehr

⊕ FDP023N08B	↔ FDP025N06	⇒ FDP025N06	D FDP027N08B	↔ FDP027N08B
⊕ FDP030N06	⊕ FDP030N06	D FDP030N06B_F102	⇒ FDP032N08	↔ FDP032N08
⊕ FDP032N08B	⊕ FDP036N10A	⊕ FDP036N10A	↔ FDP038AN06AO	↔ FDP038AN06AO
D FDP038AN06AO	⊕ FDP039N08B	⊕ FDP040N06	⊕ FDP040N06	↔ FDP045N10A
⇒ FDP045N10A	↔ FDP047AN08	⊕ FDP047AN08AO	⊕ FDP047AN08AO	↔ FDP047AN08AO
↔ FDP047N08	⇒ FDP047N08AO	D FDP047N10	⊕ FDP047N10	⊕ FDP050AN06AO
⊕ FDP050AN06AO	D FDP050AN06AO	⇒ FDP053N08B	↔ FDP053N08B_F102	↔ FDP054N10
⊕ FDP054N10	⊕ FDP060AN08AO	↔ FDP060AN08AO	⇒ FDP060AN08AO	↔ FDP060N08AO
⊕ FDP060N08AO	⊕ FDP068AN08AO	⊕ FDP070AN06AO	D FDP070AN06AO	↔ FDP070AN06AO
↔ FDP075N15A	⊕ FDP075N15A	⊕ FDP083N15A	⊕ FDP083N15A	↔ FDP083N15A_F102

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

